# LASER BEAM RECORDING MATERIAL

Patent Number:

JP57022095

Publication date:

1982-02-04

Inventor(s):

**OOTA YOSHINORI** 

Applicant(s):

**NEC CORP** 

Requested Patent:

JP57022095

Application Number: JP19800096709 19800715

Priority Number(s):

IPC Classification:

B41M5/26; G11B7/24; G11C13/04

EC Classification:

Equivalents:

JP1728717C, JP4000838B

#### Abstract

PURPOSE:To provide a large capacity and high density laser beam recording material capable of recording at low photoenergy, which is prepared by laminating on a dielectric substrate a primary metallic membrane, which causes solid reaction with a low melting point metal, and a secondary metallic membrane which is composed mainly of a low melting point metal.

CONSTITUTION: The primary metallic thin membrane 2, which causes solid reaction to a low melting point metal such as Au, etc., and the secondary metallic thin membrane 3, which is composed mainly of a low melting point metal such as In., etc., are laminated on a dielectric substrate 1 such as a plastic glass, etc. A photobeam 4 is applied onto the surface of the thin membrane to allow solid phase reaction by dispersion between these two metals to take place on a section 5 where temperature is raised by absorption of the photobeam, and recording of information is performed by difference in reflectivities of light before and after

Data supplied from the esp@cenet database - 12

**BEST AVAILABLE COPY** 

THIS PAGE BLANK (USPTO)

## ① 日本国特許庁 (JP)

①特許出顧公開

## ⑫ 公開特許公報 (A)

昭57-22095

B 41 M	5/26
G 11 B	7/24
G 11 C	13/04

識別記号 庁内整理番号 6906-2H 7247-5D

7343-5B

❸公開 昭和57年(1982)2月4日

- 🕎

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## ❷レーザビーム記録材料

20特

願 昭55-96709

金田

願 昭55(1980)7月15日

⑫発 明 者 太田義徳

東京都港区芝五丁目33番 1 号日 本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内原晋

## 明 細 書

発明の名称 レーザビーム配母材料

### 特許請求の範囲

時電体基板上に低温で低酸点金属と固相反応を 起こす第1の金属膜と低酸点金属を主成分とする 第2の金属膜を積層したことを特徴とするレーザ ビーム記録材料。

#### 発明の詳細な説明

本発明はレーザビームによって高密度に情報を 記録し、脱み出す装置の記録媒体に関するもので ある。

金属や色素材料をディスタ面に薄膜状に塗布し との塗布面上にレーザビームを集光照射すること によって金属や色素を加熱蒸発させて情報を配録 し、またこの情報を読み出す方式の配母技術は、 高密度の配録が可能であること、現像等の処理を 必要としないことなどの特長を有し、ビデオ再生 装置や大容量光メモリへの適用が行われている。

てのような記録媒体として金属と色素材料を軟べたとき、金属薄膜は色素薄膜に較べて耐薬品性長期安定性に優れている。金属薄膜として用いられている代表的な材料はピスマス(Bi) やテルル(Te)などである。これらの材料は、金属材料のうちでも熱伝導率が低いために、照射吸収され熱エネルギーに変換されるレーザビームのエネルギーを、媒体の局所的な極度上昇に有効な利用できる特長がある。しかしながら、融点が高い(ピスマスで1271℃)ため、融点に達するまでに要するエネルギーを余計に必要とするという欠点を有している。

本発明は、とのような欠点のない低い光照射エネルギーで記録するととができる、新しいレーデビーム記録媒体を提供するととを目的とする。

本発明の原理は、酵電体器板の上に設けた第1 層の存践金属の上に更に低融点の存膜金属膜の第 2層を設け、この積層された存態に光ビームを照 射し吸収させて生ずる局部的な温度上昇によって

(1)

特開昭57- 22095(2)

2 つの会属間に拡散による固相反応を生じさせ、 反応の前後による光の反射率の違いを用いて情報 の記録を実現するものである。固相反応を生ずる 温度は、第2 層の低酸点の金質が溶融する温度よ りも低い。このため金属膜を溶験蒸発させる場合 よりも低いエネルギーで情報の書込みを実現する ことができる。

本発明の辞細を更に図面を用いて説明する。第 1 図は本発明の一実施例を示す構成の概略断面図で、1 はブラスティックやガラスのような誘端体の基板、2 は鉄器電体基板の面に蒸着等によって薄膜状に一様に形成された金 (Au)、3 は同様な方法で金具薄膜2の上に一様に設けたインジウム(In)の膜である。この膜の表面に光ピーム4を集光する。光ピームを吸収し、温度が上昇した部位5 ではインジウムと金とが固相の状態で反応する。

第2 図は、反応の過程における薄膜表面での光 の反射光強度の変化を示した図で、2 層の薄膜を 設けた時点では、インジゥム膜面によって光は反 射される。インジゥム膜面は光の反射率が低く、

(3)

代りにスズを用いてもよい。この場合には反応温度は 180 で程度とインジウムの場合よりも少し高くなるが、やはり光配録に有効な材料である。また第1層に用いる材料はここでは金について述べたが、拡散による固相反応を生ずる別な、例えば銀のような材料を用いても可能である。

本発明によれば、金属の溶融蒸発によらず、融 点以下で生ずる固相反応を用いているために低い 光エネルギーで記録ができ、また反射形であるた め両面に配録することができる大容量高密度の光 ディスクを構成することができる。

#### 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例で、1 は基板、2 は 金薄膜、3 はインジウム薄膜、4 は集東光ビーム である。第2 図は書込み光照射によって複合膜中 で上昇する温度に対する膜の表面光反射率の変化 を示す図である。

代理人 办理主 1/2 原 普

第2図中A点で示す反射率を示す。シーザ光の限 射によって存膜の温度が上昇する。温度がインジ ウムの融点 156 でより低い 125 で付近まで上昇す るとインジウムと会との固相反応が急激に進み、 膜表面は会色を帯びて来て、光の反射率が増大す る(第2図中で点)。シーザ光の限射を取り去っ で薄膜の温度が下がっても、2層の会異は反応し たため、表面の光反射率は低下しない(第2図中 B点)。

.#

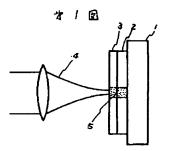
大面積の円盤にこの積層膜を設けることは容易であり、従来の光ディスク装置と組み合せること によって大容量の光メモリを構成することができる。

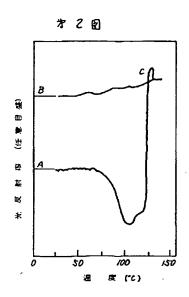
本実施例では、金,インジゥムの単なる2層膜について述べたが、従来の金属存膜光ディスタ配録体に用いられているように、この2層膜の上に光に対して透明で機械的に膜を保護する保護膜を設けたり、またこの2層膜の下に入射光を有効に利用するための反射多層膜を設けることも出来る。また、反応を起こさせる金属もインジゥムの

(4)

捐配5章 22095(3)

-3





**BEST AVAILABLE COPY** 

THIS PAGE BLANK (USPTO)